(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
16 décembre 2004 (16.12.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/109781 A1

(51) Classification internationale des brevets[7] : **H01L 21/20**, 21/762

(21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2004/001314

(22) Date de dépôt international : 27 mai 2004 (27.05.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0306568 30 mai 2003 (30.05.2003) FR

(71) Déposant *(pour tous les États désignés sauf US)* : **S.O.I. TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES** [FR/FR]; Parc Technologique des Fontaines, F-38190 BERNIN (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants *(pour US seulement)* : **LETERTRE, Fabrice** [FR/FR]; 33 Quai Jongkind, F-38000 GRENOBLE (FR). **GHYSELEN, Bruno** [FR/FR]; 58 Rue Georges Maeder, F-38170 SEYSSINET (FR). **RAYSSAC, Olivier** [FR/FR]; 7 Chemin du Chapitre, F-38100 GRENOBLE (FR).

(74) Mandataires : **JOLY, Jean-Jacques** etc.; Cabinet Beau de Loménie, 158 Rue de l'Université, F-75340 PARIS Cedex 07 (FR).

(81) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible)* : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

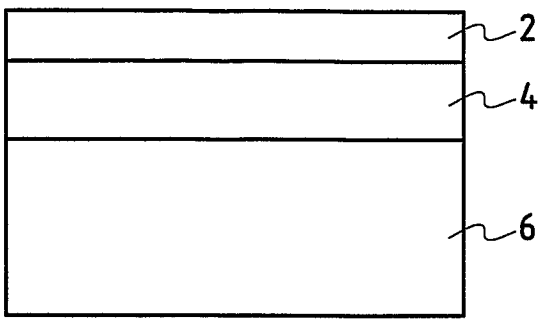
(84) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible)* : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :
— *avec rapport de recherche internationale*
— *avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues*

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) **Title:** SUBSTRATE FOR STRESSED SYSTEMS AND METHOD FOR CRYSTAL GROWTH ON SUCH A SUBSTRATE

(54) **Titre :** SUBSTRAT POUR SYSTEMES CONTRAINTS ET PROCEDE DE CROISSANCE CRISTALLINE SUR UN TEL SUBSTRAT



(57) **Abstract:** The invention relates to a support for crystalline growth, comprising a nucleation layer (2), a polycrystalline or porous buffer layer (4) and a support layer (6).

(57) **Abrégé :** L'invention concerne un support pour croissance cristalline comportant : - une couche (2) de nucléation, - une couche tampon (4), polycristalline ou poreuse, - un substrat support (6).

WO 2004/109781 A1